

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2026/098588 A1

(43) 国际公布日
2026 年 5 月 15 日 (15.05.2026)

(51) 国际专利分类号:
B24B 29/02 (2006.01) **B24B 49/02** (2006.01)
B24B 41/047 (2006.01) **B24B 19/22** (2006.01)
B24B 49/14 (2006.01) **B24B 1/00** (2006.01)
B24B 55/00 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/133196

(22) 国际申请日: 2025 年 11 月 7 日 (07.11.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202411582864.9 2024 年 11 月 7 日 (07.11.2024) CN

(71) 申请人: 西安奕斯伟材料科技股份有限公司
(**XI'AN ESWIN MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国陕西省西安市高新区西洋南路1888号1-3-029室 710100 (CN)。

(72) 发明人: 贺云鹏(**HE, Yunpeng**); 中国陕西省西安市高新区西洋南路1888号1-3-029室 710100 (CN)。
王明(**WANG, Ming**); 中国陕西省西安市高新区西洋南路1888号1-3-029室 710100 (CN)。

(74) 代理人: 北京银龙知识产权代理有限公司(**DRAGON INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM**); 中国北京市海淀区西直门北大街32号院枫蓝国际中心2号楼10层 100082 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,

(54) **Title:** POLISHING METHOD, POLISHING DEVICE AND SILICON WAFER

(54) 发明名称: 抛光方法、抛光设备及硅片

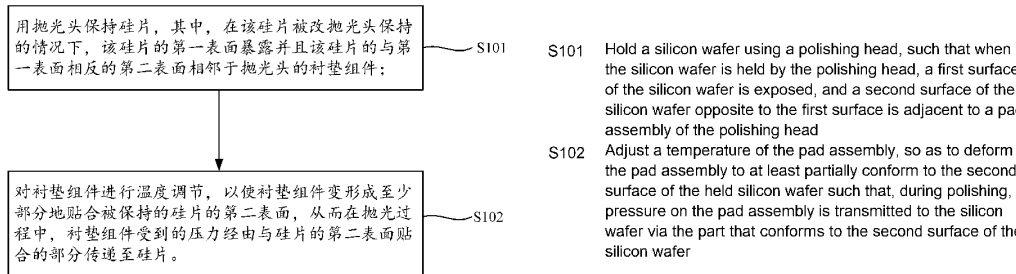


图 2

(57) **Abstract:** Embodiments of the present disclosure provide a polishing method, a polishing device, and a silicon wafer. The polishing method comprises: holding a silicon wafer using a polishing head, such that when the silicon wafer is held by the polishing head, a first surface of the silicon wafer is exposed, and a second surface of the silicon wafer opposite to the first surface is adjacent to a pad assembly of the polishing head; and adjusting a temperature of the pad assembly, so as to deform the pad assembly to at least partially conform to the second surface of the held silicon wafer, such that, during polishing, pressure on the pad assembly is transmitted to the silicon wafer via the part that conforms to the second surface of the silicon wafer.

(57) 摘要: 本公开实施例提出了抛光方法、抛光设备及硅片, 所述抛光方法包括: 用抛光头保持硅片, 其中, 在所述硅片被所述抛光头保持的情况下, 所述硅片的第一表面暴露并且所述硅片的与所述第一表面相反的第二表面与所述抛光头的衬垫组件相邻; 对所述衬垫组件进行温度调节, 以使所述衬垫组件变形至少部分地贴合被保持的所述硅片的所述第二表面, 从而在抛光过程中, 所述衬垫组件受到的压力经由与所述硅片的所述第二表面贴合的部分传递至所述硅片。

[见续页]

WO 2026/098588 A1

SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MU, MW,
MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧
亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ,
CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。